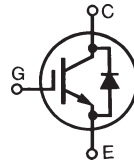


High Voltage, High Gain BIMOSFET™

IXBF55N300

Monolithic Bipolar MOS Transistor

(Electrically Isolated Tab)



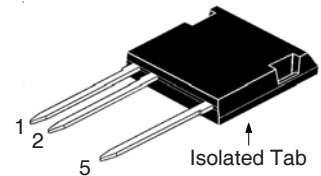
$$V_{CES} = 3000V$$

$$I_{C110} = 34A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 3.2V$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	3000	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	3000	V
V_{GES}	Continuous	± 25	V
V_{GEM}	Transient	± 35	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	86	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	34	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	600	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 2\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 110$ $V_{CE} \leq 0.8 \cdot V_{CES}$	A
T_{SC} (SCSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_J = 125^\circ C$, $R_G = 10\Omega$, $V_{CE} = 1250V$, Non-Repetitive	10	μs
P_C	$T_C = 25^\circ C$	357	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force	20..120 / 4.5..27	Nm/lb.in.
V_{ISOL}	50/60Hz, 1 Minute	4000	V~
Weight		5	g

ISOPLUS i4-Pak™



1 = Gate
2 = Emitter

5 = Collector

Features

- Silicon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
- Isolated Mounting Surface
- 4000V~ Electrical Isolation
- High Blocking Voltage
- High Peak Current Capability
- Low Saturation Voltage

Advantages

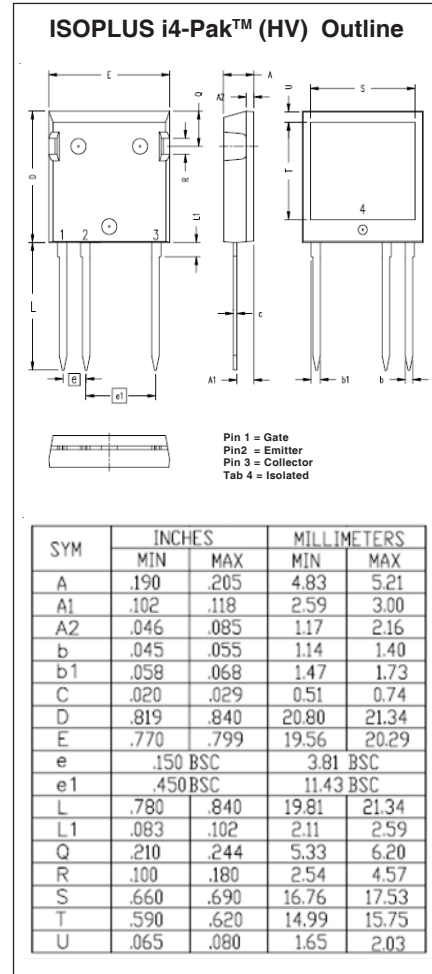
- Low Gate Drive Requirement
- High Power Density

Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Laser Generators
- Capacitor Discharge Circuits
- AC Switches

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 1mA$, $V_{GE} = 0V$	3000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 4mA$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ Note 2, $T_J = 125^\circ C$			50 μA 3 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 25V$			± 200 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 55A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.7 3.3	3.2 V V

Symbol Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)		Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 55\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}, \text{Note 1}$	32	50	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		7300	pF
C_{oes}			275	pF
C_{res}			83	pF
Q_g	$I_C = 55\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 1000\text{V}$		335	nC
Q_{ge}			47	nC
Q_{gc}			130	nC
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 110\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 1250\text{V}, R_G = 2\Omega$		54	ns
t_r			307	ns
$t_{d(off)}$			230	ns
t_f			268	ns
R_{thJC}				0.35 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}		0.15	$^\circ\text{C/W}$	



Reverse Diode

Symbol Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)		Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 55\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, \text{Note 1}$			2.5 V
t_{rr}	$I_F = 28\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$		1.9	μs
I_{RM}		$V_R = 100\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		54

Notes:

1. Pulse test, $t < 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d < 2\%$.
2. Device must be heatsunk for high-temperature leakage current measurements to avoid thermal runaway.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

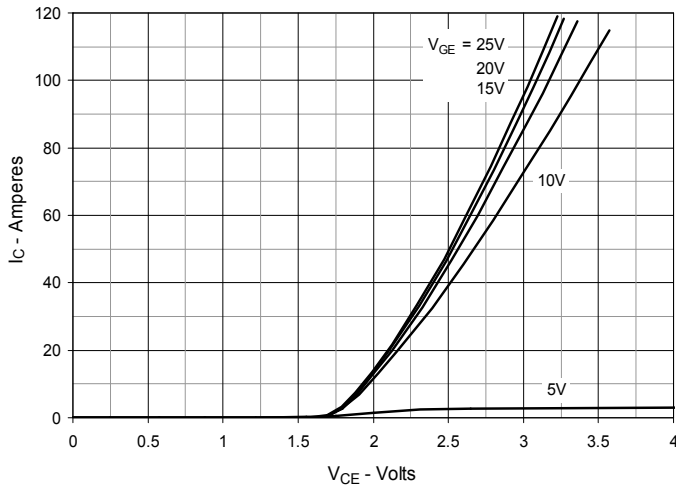
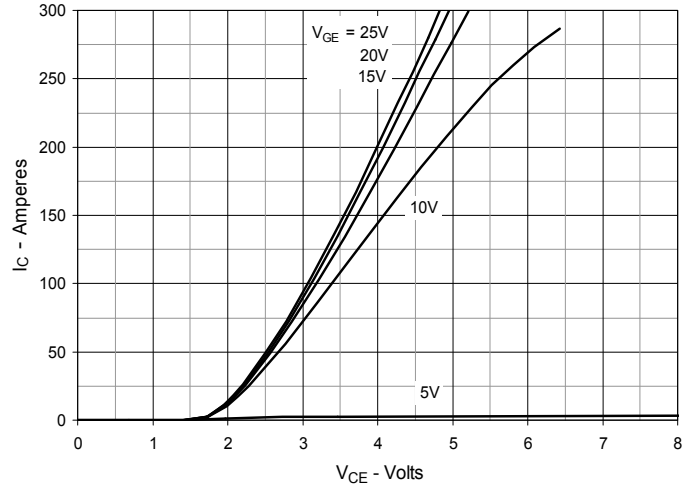
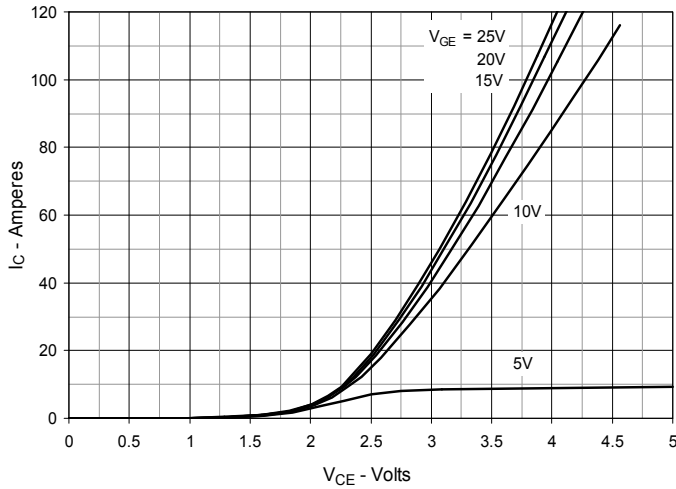
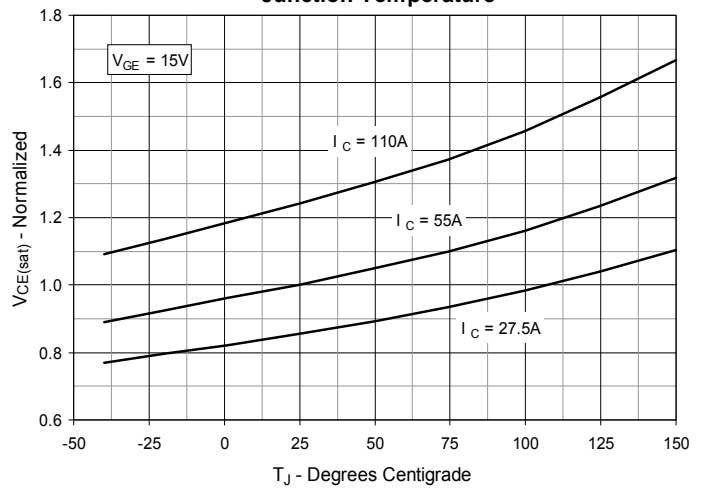
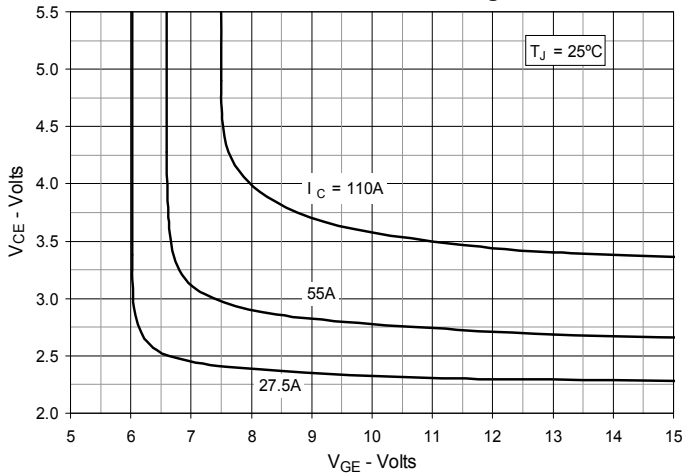
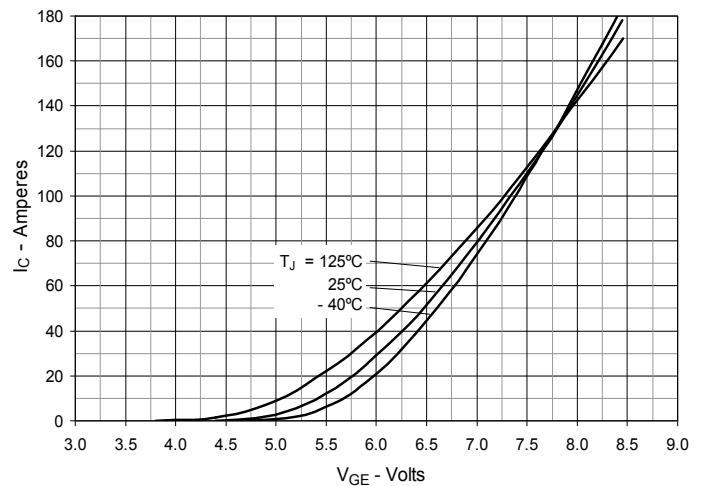
Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

Fig. 6. Input Admittance


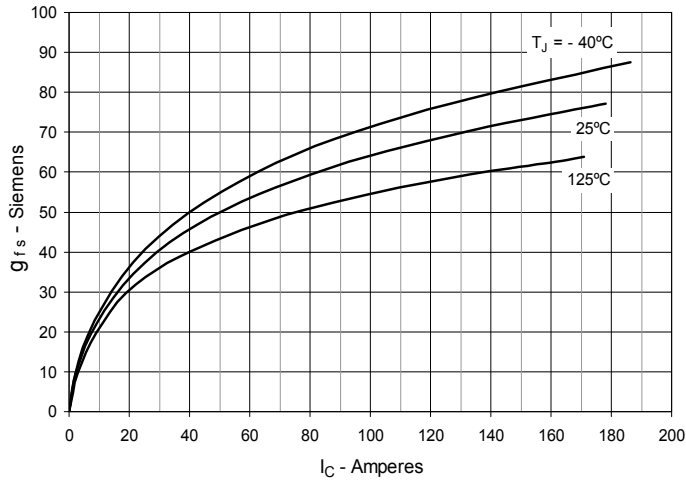
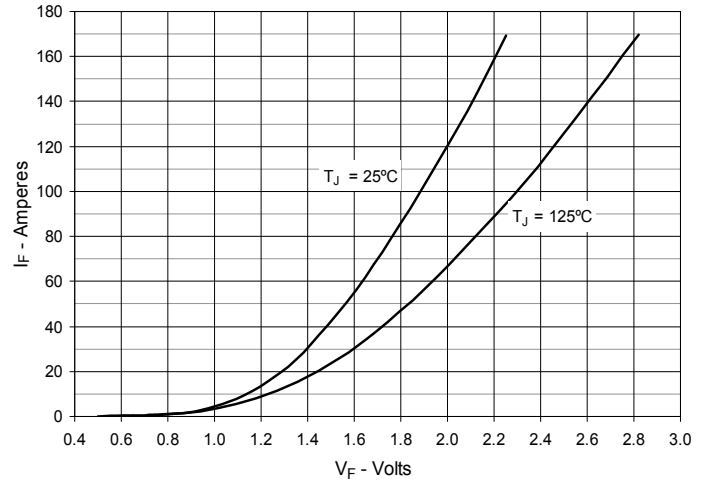
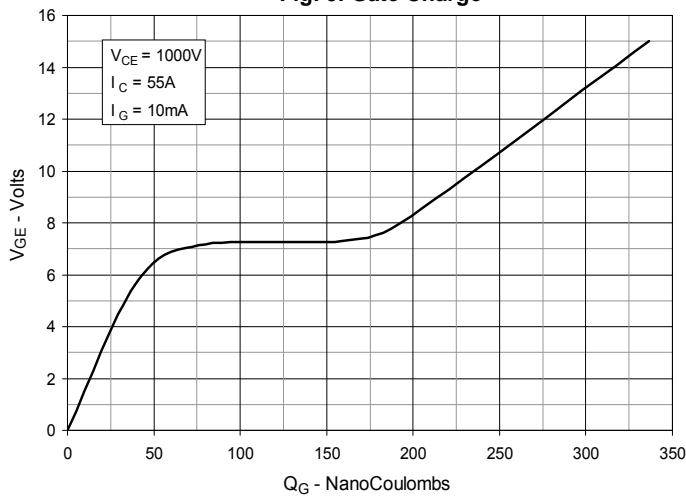
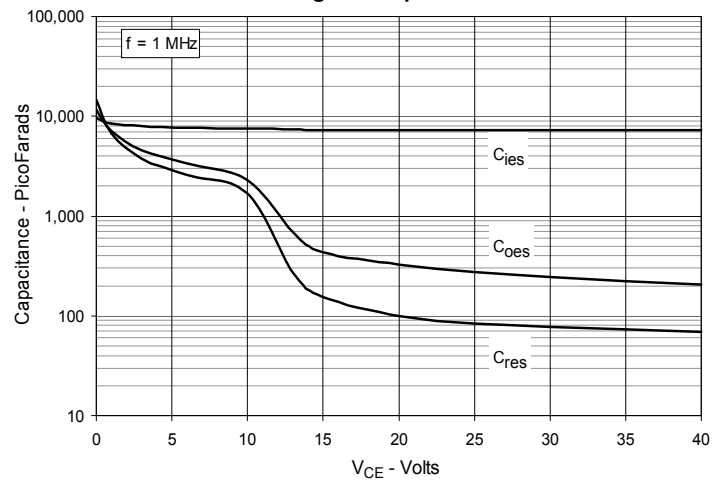
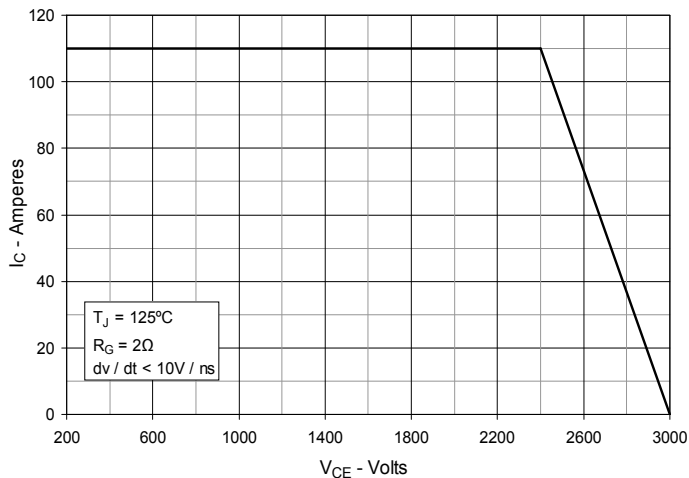
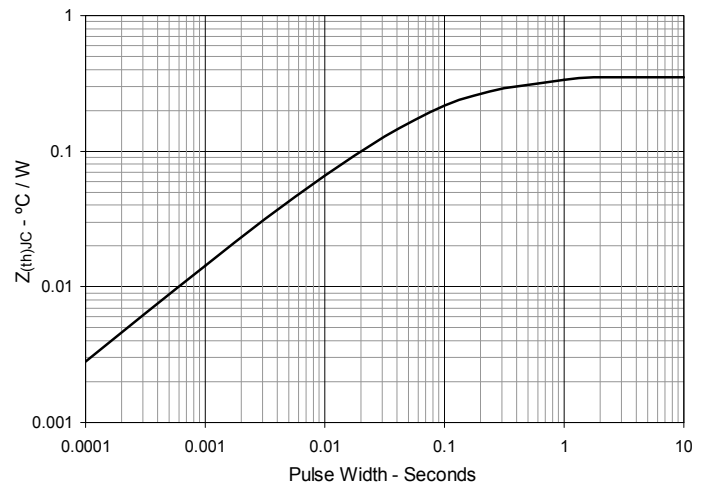
Fig. 7. Transconductance

Fig. 8. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

Fig. 9. Gate Charge

Fig. 10. Capacitance

Fig. 11. Reverse-Bias Safe Operating Area

Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance


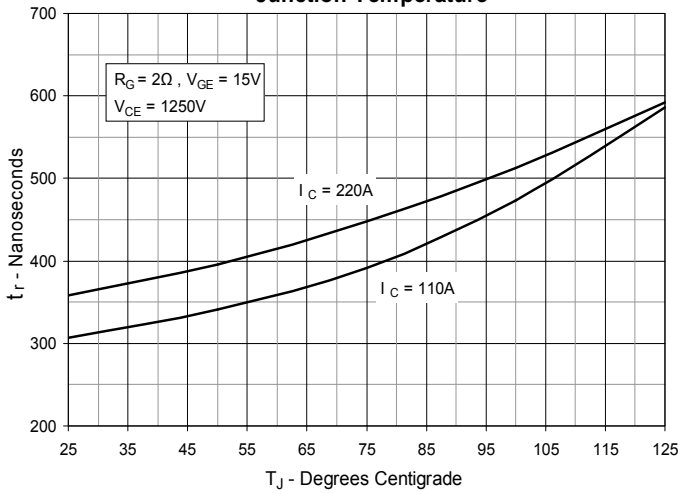
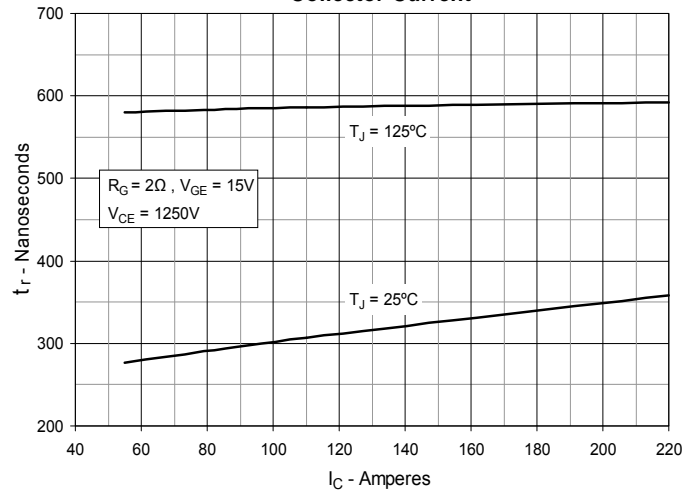
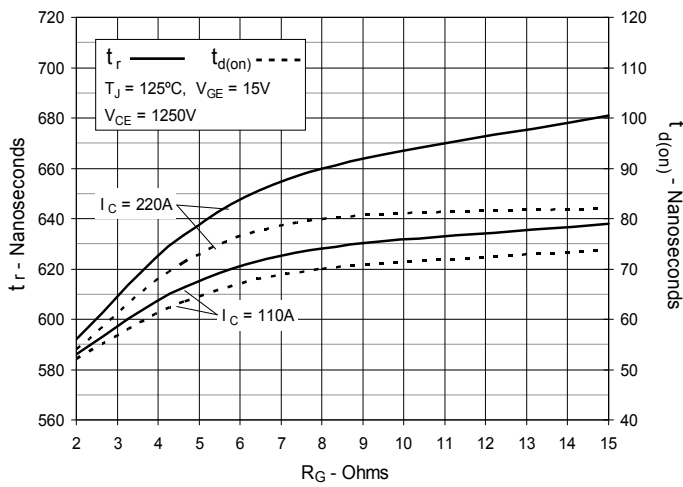
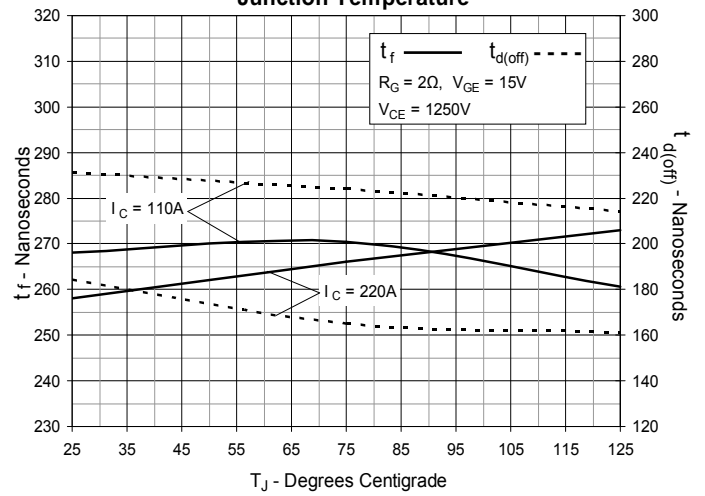
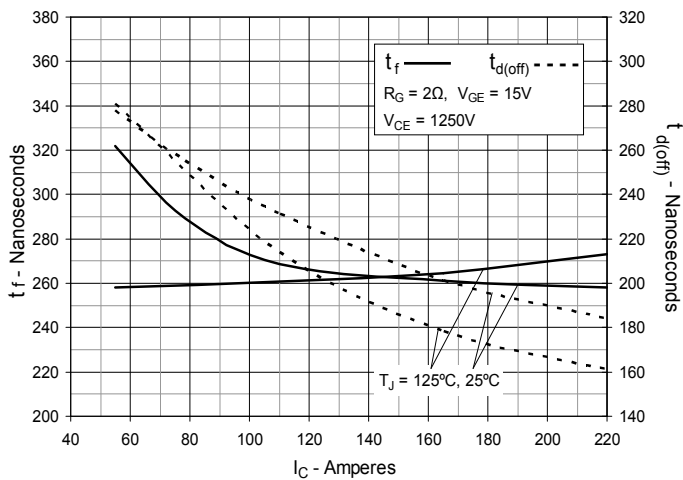
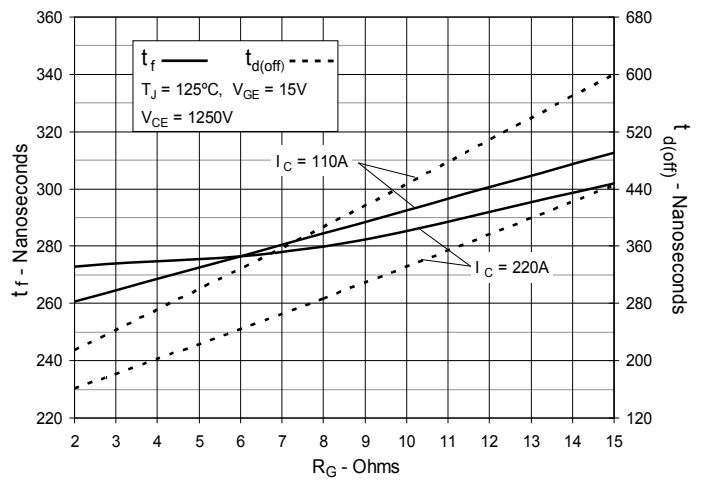
Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature

Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current

Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance

Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature

Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current

Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance


Fig. 19. Forward-Bias Safe Operating Area

@ $T_C = 25^\circ\text{C}$

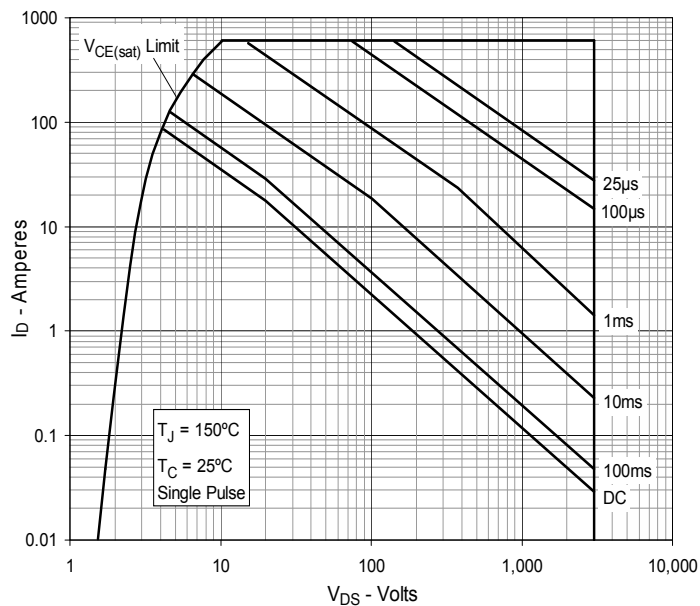
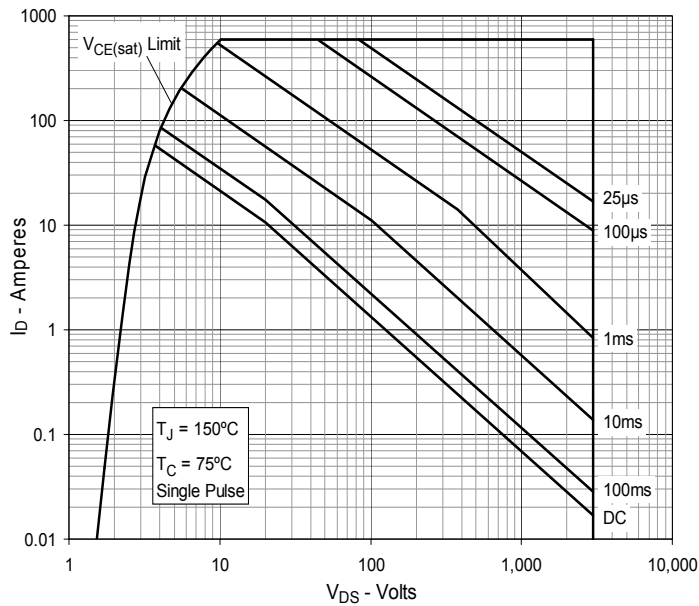


Fig. 20. Forward-Bias Safe Operating Area

@ $T_C = 75^\circ\text{C}$





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331